

武汉高德红外股份有限公司

关于高性能长波、中长波双色制冷红外探测器项目

通过科技成果鉴定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，中国电子学会对我公司联合某科研院所、武汉高芯科技有限公司研制的“基于铋化物超晶格的高性能长波、中长波双色制冷红外探测器”项目进行了科技成果鉴定。鉴定委员会听取了项目的研制报告、技术报告、应用报告及经济效益和社会效益分析报告，观看了系统演示，审阅了查新报告、测试报告和资料审查报告，经过质询和讨论，鉴定委员会通过鉴定。

一、鉴定结论

鉴定委员会认为：本项目基于铋化物超晶格材料研制高性能长波和中长波双色制冷红外焦平面探测器，攻克了基于 InAs/GaSb 和 InAs/GaSb/AlSb 超晶格的结构设计、分子束外延生长、红外光电物性分析、大规模焦平面制备工艺、高可靠性组件封装等一系列自主关键技术，研制出了阵列规模 640×512 像素的高性能长波制冷红外焦平面探测器和阵列规模 320×256 像素的高性能中长波双色制冷红外焦平面探测器，并实现了红外成像，实现了实验室研究成果向产业化技术的转化。本项目研制的基于铋化物超晶格材料研制高性能长波、中长波双色制冷红外焦平面探测器，该技术创新性强，具有多项自主知识产权，成果满足国内军民市场的重大战略需求，应用前景广泛，该技术水平达到国内领先、国际先进。鉴定委员会同意此成果通过鉴定。

二、技术突破的意义及对公司未来影响

铋化物超晶格红外探测技术的研制成功，可以解决我国在高性能红外探测器技术方面材料技术和工艺技术的瓶颈，打破欧美国家对我国的技术封锁，保障我国军事安全，满足航空航天、深空探测、预警监测等前沿技术部署需求；提升我国红外探测技术在全球市场的竞争力，抢占全球灾害预警、医疗免疫、工业检测、气体检测等民用消费市场；提升国家整体科技与经济实力。

该项技术成果通过核准鉴定，将会对公司 II 类超晶格红外焦平面探测器产业化的顺利实现起到积极的推动作用，对公司核心器件实现降低成本、市场拓展等方面具有重要价值，未来将以此为基础衍生开发出更大面阵、更长探测波段、更高技术指标的 II 类超晶格材料单色、双色甚至多色红外焦平面芯片产品。

三、风险提示

公司募集资金投资项目建设的制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目现正处于产业化建设阶段，经济效益需要一定时间才能体现。公司将根据 II 类超晶格红外探测器产业化项目建设进展情况及时进行公告，公司提示投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十日